別表第八四・四二項中「加工機械」を「機械」に改める。

別表第八四・五六項中

| | |
|---|---|
| 八四五六・一〇 | レーザーその他の光子ビームによるもの |
| 八四五六・一一 | レーザーその他の光子ビームによるもの |
| 八四五六・一二 | レーザーによるもの |
| | その他の光子ビームによるもの |
| ―― | 無税 |

を

| | |
|---|---|
| 八四五六・一一 | レーザーその他の光子ビームによるもの |
| 八四五六・一二 | レーザーによるもの |
| | その他の光子ビームによるもの |
| ―― | 無税 |

に改め、同表第八四五六・三〇号の次に次の二号を加える。

| | |
|---|---|
| 八四五六・四〇 | プラズマアークによるもの |
| 八四五六・五〇 | ウォータージェット切断機械 |
| ―― | 無税 |

別表第八四・五九項中

| | |
|---|---|
| 八四五九・四〇 | その他の中ぐり盤 |
| | ひざ形フライス盤 |
| | その他の中ぐり盤 |
| | 数値制御式のもの |
| | その他のもの |
| | 膝形フライス盤 |
| ―― | 無税 |

を

| | |
|---|---|
| 八四五九・四一 | その他の中ぐり盤 |
| | 数値制御式のもの |
| 八四五九・四九 | その他のもの |
| | 膝形フライス盤 |
| ―― | 無税 |

に改める。

別表第八四・六〇項中

| | |
|---|---|
| 八四六〇・一一 | 平面研削盤（軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。） |
| 八四六〇・一九 | 数値制御式のもの |
| | その他のもの |
| | その他の研削盤（軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。） |
| 八四六〇・二一 | 数値制御式のもの |
| | 平面研削盤 |
| 八四六〇・一二 | 数値制御式のもの |
| | その他のもの |
| | その他の研削盤 |
| 八四六〇・二二 | 芯無し研削盤（数値制御式のものに限る。） |
| 八四六〇・二三 | その他の円筒研削盤（数値制御式のものに限る。） |
| 八四六〇・二四 | その他のもの（数値制御式のものに限る。） |

を

| | |
|---|---|
| 八四六〇・一二 | 平面研削盤（軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。） |
| 八四六〇・一九 | 数値制御式のもの |
| | その他のもの |
| | その他の研削盤（軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。） |
| 八四六〇・二一 | 数値制御式のもの |
| | 平面研削盤 |
| 八四六〇・一一 | 数値制御式のもの |
| | その他のもの |
| | その他の研削盤 |
| 八四六〇・二二 | 芯無し研削盤（数値制御式のものに限る。） |
| 八四六〇・二三 | その他の円筒研削盤（数値制御式のものに限る。） |
| 八四六〇・二四 | その他のもの（数値制御式のものに限る。） |
| ―― | 無税 |

に改める。

別表第八四六五・一〇号の次に次の一号を加える。

| | |
|---|---|
| 八四六五・二〇 | マシニングセンター |
| ―― | 無税 |

別表第八四・六六項中「加工機械」を「機械」に改める。

別表第八四・六九項を削る。

別表第八四・七三項中「第八四・六九項から第八四・七二項までの機械」を「第八四・七〇項から第八四・七二項までの機械」に改め、同表第八四七三・一〇号を削り、同表第八四七三・五〇号中「第八四・六九項」を「第八四・七〇項」に改める。

別表第八五類の注9を10とし、同注8(b)に次のように加える。

(iv) マルチコンポーネント集積回路（MCO）（一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント（シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第八五・三二項、第八五・三三項若しくは第八五・四一項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第八五・〇四項に属するインダクター）とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板（PCB）その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの）

この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にMCOの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。

2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。

3 (a) 「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によって生ずる物理量又は化学量を電気信号に変換する機能を有するものである。「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。

(b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。

(c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。

(d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。

別表第八五類の注8中「この注8」を「この注9」に改め、同注中8を9とし、7を8とし、6を7とし、5を6とし、4を5とし、3を4とし、2の次に次のように加える。

3 第八五・〇七項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品（例えば、接続子、温度制御装置（サーミスター等）及び回路保護装置）とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。